



## Travaux Dirigés Libres n°2 : Électronique 1

### Exercice n°1 : Notation complexe

On considère les courants électriques sinusoïdaux suivant :

$$i_1(t) = I_1 \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_1) \quad \text{et} \quad i_2(t) = I_2 \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_2).$$

On suppose que :  $I_1 > I_2$  et  $0 < \varphi_1 < \varphi_2$

Par une méthode de votre choix « Fresnel ou notation complexe », calculer :

1°) La somme  $i(t) = i_1(t) + i_2(t)$  par une recherche de  $I_S$  et  $\varphi_S$ .

2°) La dérivée  $\frac{di(t)}{dt}$  par une recherche de  $I_d$  et  $\varphi_d$ .

3°) L'intégrale  $\int i(t) dt$  par une recherche de  $I_i$  et  $\varphi_i$ .

4°) Le produit  $i_p(t) = i_1(t) \times i_2(t)$  par une recherche de  $I_p$  et  $\varphi_p$ .

### Exercice n°2 : Impédance complexe et admittance complexe

1°) Déterminer l'impédance complexe  $\underline{Z}$  et l'admittance complexe  $\underline{Y}$  des dipôles schématisés ci-dessous.

2°) En déduire pour chacun :

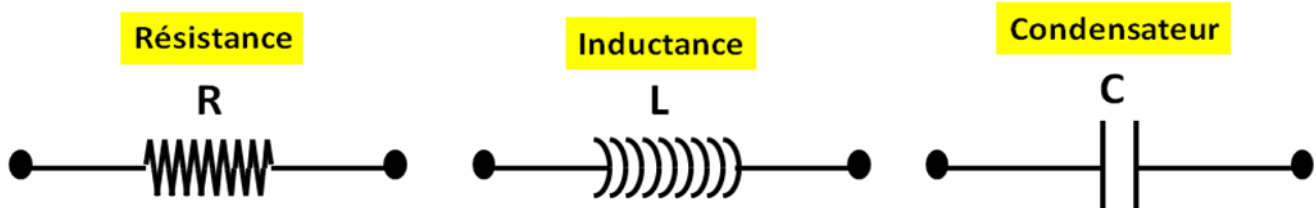
a°) l'impédance  $Z$  et l'admittance  $Y$

b°) le déphasage  $\varphi$  de l'impédance et le déphasage  $\psi$  de l'admittance.

c°) la résistance du dipôle  $R$  et la conductance du dipôle  $G$ .

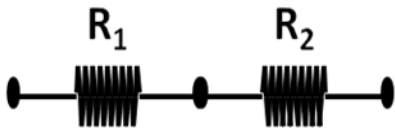
d°) la réactance du dipôle  $X$  et la susceptance du dipôle  $B$ .

### Dipôles élémentaires :

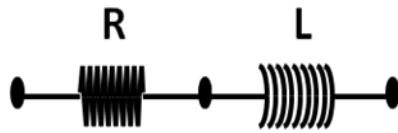


Dipôles quelconques :

Dipôle n°1



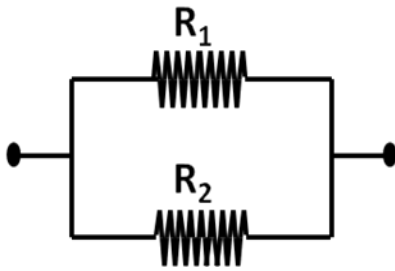
Dipôle n°2



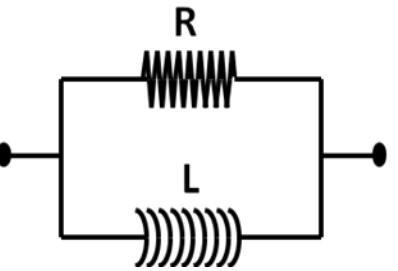
Dipôle n°3



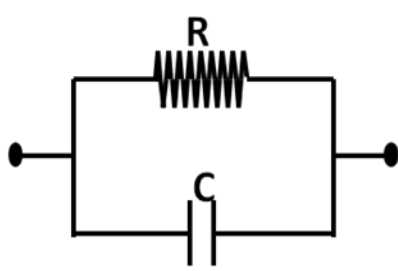
Dipôle n°4



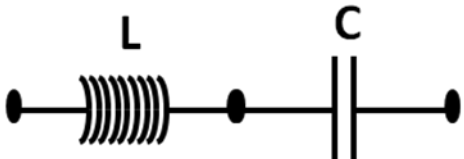
Dipôle n°5



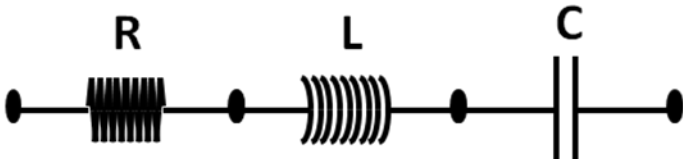
Dipôle n°6



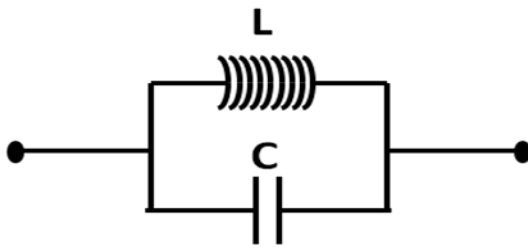
Dipôle n°7



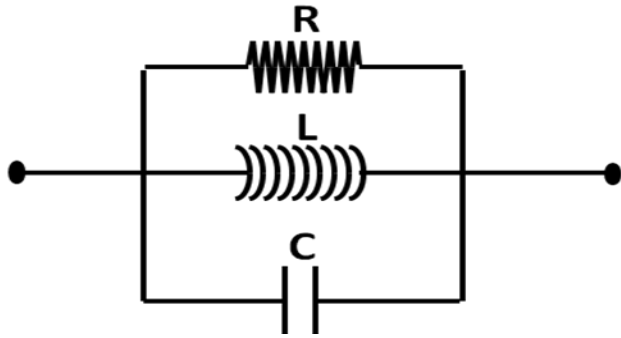
Dipôle n°8



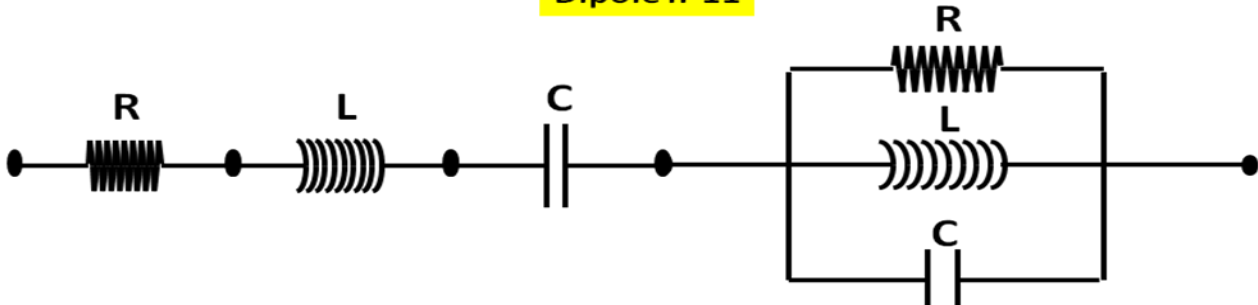
Dipôle n°9



Dipôle n°10



Dipôle n°11



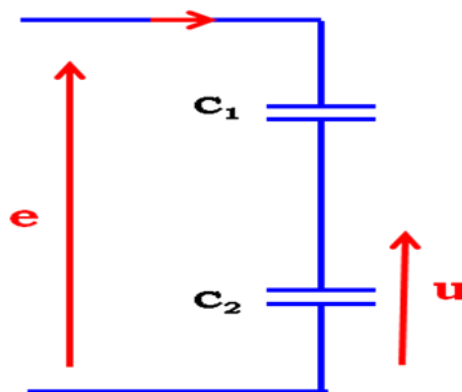
### Exercice n°3 : Dipôles en régime alternatif sinusoïdal

Pour les six circuits proposés ci-dessous, on demande d'abord de calculer les caractéristiques du dipôle suivantes :

- L'impédance complexe  $\underline{Z}$ , la résistance du dipôle  $R$ , la réactance du dipôle  $X$ , l'impédance réelle  $Z$  et le déphasage  $\varphi$ .
- L'admittance complexe  $\underline{Y}$ , la conductance du dipôle  $G$ , la susceptance du dipôle  $B$ , l'admittance réelle  $Y$  et le déphasage  $\psi$ .

Vous répondez ensuite aux questions relatives à chaque circuit.

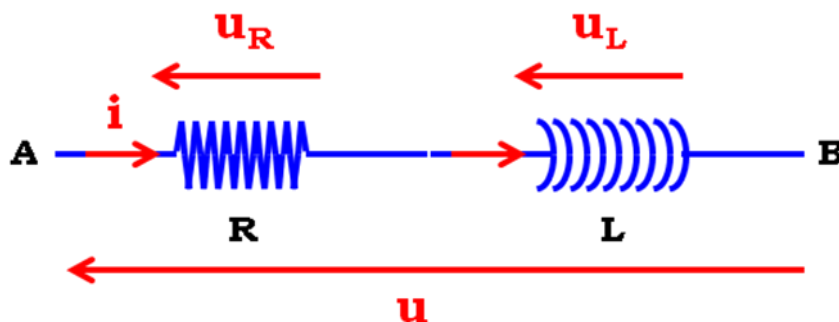
#### **Circuit n°1**



- 1°) Exprimer  $\underline{u}$  en fonction de  $C_1$ ,  $C_2$  et  $\underline{e}$ .
- 2°) En déduire la relation entre  $u$  et  $e$  et le déphasage entre ces deux tensions.
- 3°) Calculer  $u$ .

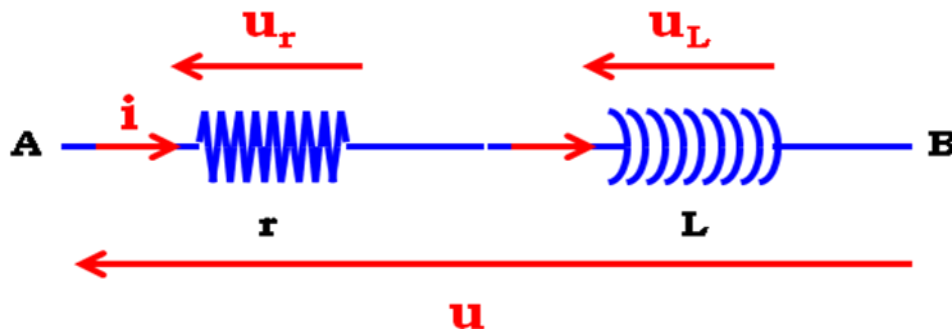
**A.N.**  $C_1 = 100 \text{ nF}$ ,  $C_2 = 10 \text{ nF}$ ,  $E = 10 \text{ V}$ .

#### **Circuit n°2**



On donne :  $R = 12 \Omega$  ;  $L = 2 \text{ mH}$  ;  $U_{\text{eff}} = 1 \text{ V}$  ;  $f = 1 \text{ kHz}$ .

- 1°) Déterminer l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB :  $\underline{Z}_{AB}$
- 2°) En déduire l'impédance  $Z_{AB}$  (en  $\Omega$ ).
- 3°) Calculer le courant efficace  $I_{\text{eff}}$  et les tensions efficaces  $U_{R \text{ eff}}$  et  $U_{L \text{ eff}}$ .
- 4°) Calculer le déphasage entre  $u$  et  $i$  :  $\varphi_{u/i}$  (en  $^\circ$ ).
- 5°) En déduire le déphasage entre  $u$  et  $u_L$  :  $\varphi_{u/u_L}$  (en  $^\circ$ ).

**Circuit n°3**

La bobine d'un électroaimant est équivalente à une bobine parfaite d'inductance  $L$  en série avec une résistance interne  $r$ .

Elle est alimentée par une tension sinusoïdale alternative de valeur efficace  $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$  et de fréquence  $f = 50 \text{ Hz}$ .

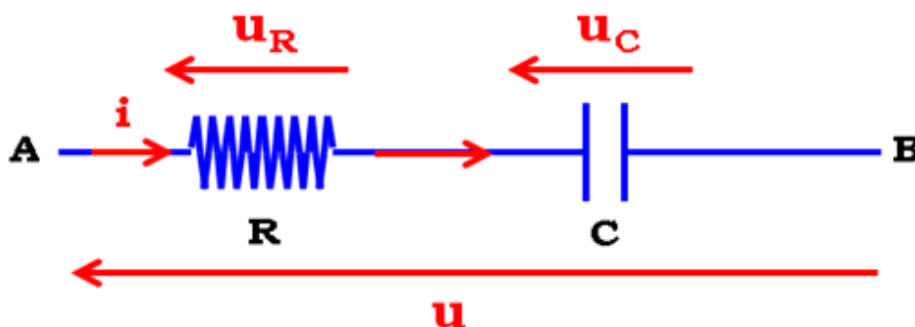
La bobine consomme 50 watts et un courant efficace  $I_{\text{eff}} = 0,5 \text{ A}$ .

1°) Calculer sa résistance interne  $r$ .

2°) Calculer son impédance  $Z$ .

3°) En déduire son inductance  $L$ .

4°) Calculer son facteur de puissance  $\cos\varphi$  ( $\varphi$  désigne le déphasage entre tension  $u$  et courant  $i$ ).

**Circuit n°4**

1°) Calculer les tensions efficaces  $U_{R \text{ eff}}$  et  $U_{C \text{ eff}}$ .

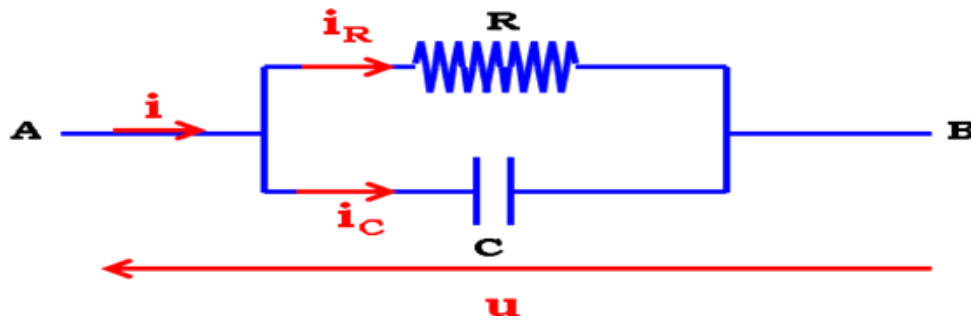
2°) Déterminer l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB :  $\underline{Z}_{AB}$

3°) Calculer l'impédance  $Z_{AB}$  (en  $\Omega$ ).

4°) Calculer  $U_{\text{eff}}$ .

5°) Calculer le déphasage entre  $u$  et  $i$  :  $\varphi_{u/i}$  (en  $^\circ$ ).

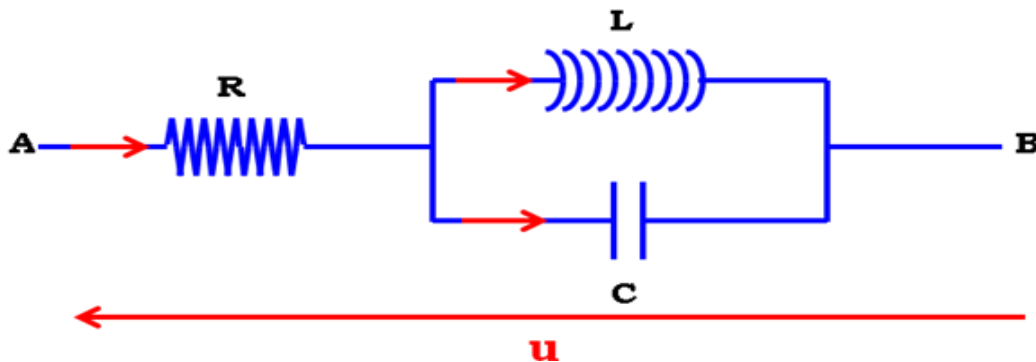
On donne :  $R = 4,7 \text{ k}\Omega$  ;  $C = 5,6 \text{ nF}$  ;  $I_{\text{eff}} = 400 \mu\text{A}$  ;  $f = 10 \text{ kHz}$ .

**Circuit n°5**

On donne  $U = 10 \text{ V}$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ ,  $R = 10 \text{ k}\Omega$  et  $C = 1 \mu\text{F}$ .

1°) Calculer  $I_R$  et  $I_C$ .

2°) Calculer  $I$  et  $\varphi_{u/i}$  (au préalable, déterminer l'admittance complexe équivalente :  $\underline{Y}_{AB}$ ).

**Circuit n°6**

1°) Montrer que l'impédance complexe du circuit peut s'écrire :  $\underline{Z} = R - j \frac{L\omega}{LC\omega^2 - 1}$

2°) Pour quelle fréquence le courant  $i$  est-il nul ?

**A.N.**  $L = 10 \mu\text{H}$ ,  $C = 22 \text{ nF}$ .

**Exercice n°4 : Théorèmes généraux**

En utilisant une méthode de votre choix, calculer pour chacun des circuits linéaires proposés ci-dessous, le courant  $i(t)$  circulant dans l'élément placé entre les points **A** et **B**, ainsi que la tension  $u(t)$  lui correspondant.

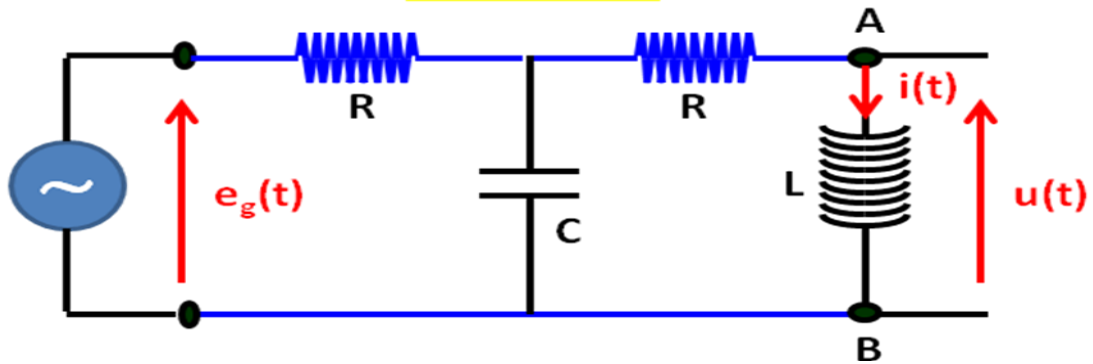
On suppose, pour le calcul, que la forme des sources de tension  $e_g(t)$  et de courant  $i_g(t)$  est exprimée respectivement comme suit :

$$e_g(t) = E_g \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_{e_g}) \quad \text{et} \quad i_g(t) = I_g \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_{i_g})$$

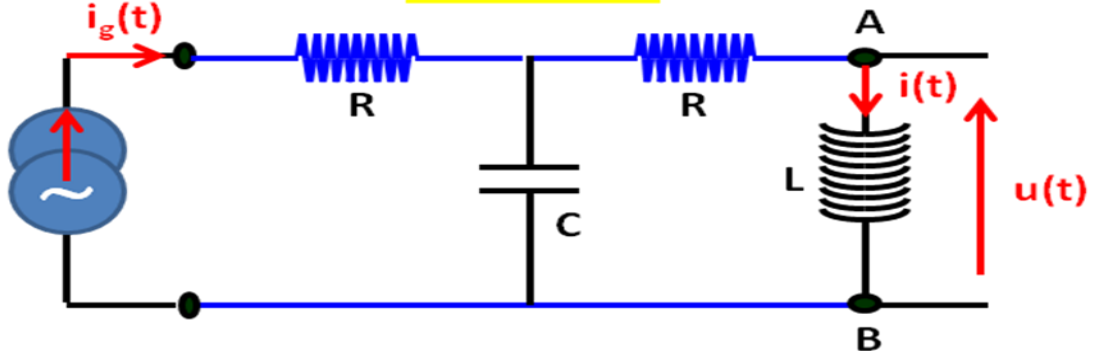
Le résultat de calcul de courant  $i(t)$  et celui de la tension  $u(t)$  est linéaire, il doit avoir la même forme que celle de la source :

$$i(t) = I \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_i) \quad \text{et} \quad u(t) = U \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_u)$$

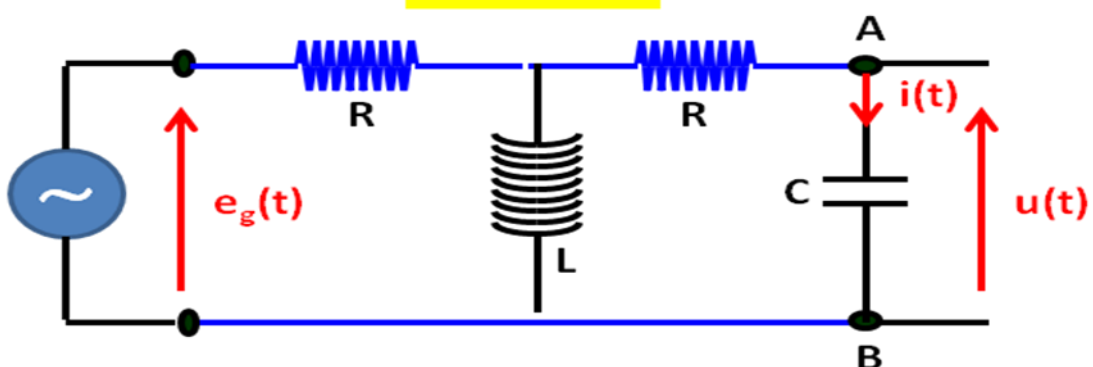
Circuit n°1



Circuit n°2



Circuit n°3



Circuit n°4

